

	<p>SI4491EDY-T1-GE3</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4491EDY-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 17.3A 8-SO</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4491EDY-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 24298 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	






Spezifikationen

Teilenummer	SI4491EDY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 17.3A 8-SO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	24298 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.8V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.5 mOhm @ 13A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 6.9W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4620pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	153nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17.3A (Ta)

SI4491EDY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4491EDY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4491EDY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4491EDY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4493DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 10A 8SOIC</p>	 <p>SI4490DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 2.85A 8-SOIC</p>	 <p>SI4493DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 10A 8SOIC</p>	 <p>SI4490DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 2.85A 8-SOIC</p>
 <p>SI4491EDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 17.3A 8-SO</p>	 <p>SI4491EDY-T1-E3 V SI4491EDY-T1-E3 V</p>	 <p>SI4491DY-T1-GE3 VB SI4491DY-T1-GE3 VB</p>	 <p>SI4493DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 10A 8SOIC</p>

SI4491EDY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI4491EDY-T1-GE3	Vishay / Siliconix	SI4491EDY-T1-GE3 Datenblatt	SI4491EDY-T1-GE3-Datenblätter	SI4491EDY-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI4491EDY-T1-GE3
SI4491EDY-T1-GE3 Electronic	SI4491EDY-T1-GE3-Komponenten	SI4491EDY-T1-GE3-Verteiler	SI4491EDY-T1-GE3-Bild	SI4491EDY-T1-GE3-Bild	SI4491EDY-T1-GE3-Teil
SI4491EDY-T1-GE3 Preis	SI4491EDY-T1-GE3 Hersteller	SI4491EDY-T1-GE3 Bild	SI4491EDY-T1-GE3 Aktie	SI4491EDY-T1-GE3 Inventar	SI4491EDY-T1-GE3 Inventar
SI4491EDY-T1-GE3 Neu	SI4491EDY-T1-GE3 Original	SI4491EDY-T1-GE3 garantiert	SI4491EDY-T1-GE3 RFQ	SI4491EDY-T1-GE3 Online bestellen	SI4491EDY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited